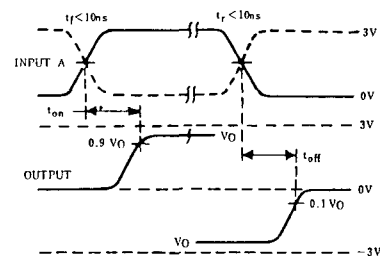
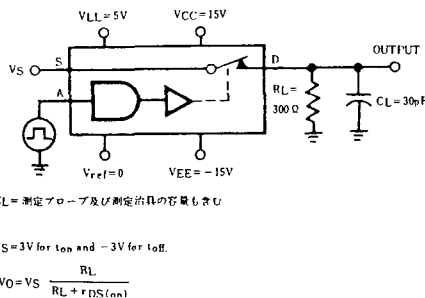


TL185 DPST BI-MOS アナログ・スイッチ (つづき)

負荷軽減表

パッケージ	全損失	負荷軽減率	適用周囲温度	デバイス・タイプ
J (アロイ・マウント)	1375mW	11.0mW/°C	25°C以上	TL185MJ
J (ガラス・マウント)	1025mW	8.2mW/°C	25°C以上	TL185IJ、TL185CJ
N	1150mW	9.2mW/°C	25°C以上	TL185IN、TL185CN
NS	694mW	5.6mW/°C	25°C以上	TL185CNS

図1. スイッチング時間測定回路



タイミング波形

記号	測定条件		TL185M			TL185I			TL185C			単位
			最小	標準	最大	最小	標準	最大	最小	標準	最大	
$r_{DS(ON)}$	$V_D = -10V$ $I_S = 1mA, V_{IH} = 2V$	$T_a = \min \sim 25^\circ C$			125			150			150	Ω
		$T_a = \max$			250			300			300	
I_{CC}	全コントロール入力=0 $T_a = 25^\circ C$				1.5			1.5			1.5	mA
I_{EE}				-5			-5			-5		
I_{LL}				4.5			4.5			4.5		
$I_{IN(REF)}$				-2			-2			-2		
I_{CC}	全コントロール入力=5V $T_a = 25^\circ C$				1.5			1.5			1.5	mA
I_{EE}				-5			-5			-5		
I_{LL}				4.5			4.5			4.5		
$I_{IN(REF)}$				-2			-2			-2		
t_{on}	$V_{CC} = 10V, V_{EE} = -20V, T_a = 25^\circ C$			175			175			175	ns	
t_{off}	$R_L = 300\Omega, C_L = 30pF$ (図1参照)			350			350			350		